WASHING TOOTH BRUSH

Publication number:

JP4197307

Publication date:

1992-07-16

Inventor:

ONODA KINJI; NAKAGAWA YOSHINORI

Applicant:

SHIKEN KK

Classification:

- International:

A46B15/00; A46B15/00; (IPC1-7): A46B15/00

- European:

Application number:

JP19900334512 19901129

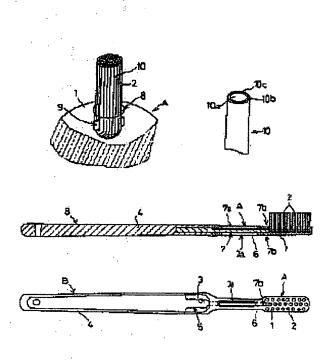
Priority number(s):

JP19900334512 19901129

Report a data error here

Abstract of JP4197307

PURPOSE: To provide a washing brush which can be simply manufactured without a special process and can be used for a long period of time by evaporating an N-type semiconductor material which causes a photoelectric chemical reaction on receiving external light at the time of washing on the surface of a brush structural member. CONSTITUTION:A semiconductor brush bristle 10 is formed by evaporating metal titanium Ti, 10b which is an N-type semiconductor material, on the surface of a nylon filament 10a, oxidizing the surface thereof to form a very thin anatase titanium dioxide TiO2 layer 10c, and cutting the same to a designated length. When the moisture on the tooth root side comes into contact with the semiconductor brush bristle 10 and external light is applied directly to the N-type semiconductor 10c of the surface of the semiconductor brush bristle 10 or indirectly applied thereto through a transparent brush bristle 2 and a transparent base material 1 at the time of cleaning the teeth, a photoelectric chemical reaction is caused. As only one semiconductor brush bristle 10 is contained in each bundle of brush bristles 2, no feeling of foreign matter is given to a user at the time of cleaning the teeth.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-197307

®Int. Cl. 5

識別記号

创特

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)7月16日

A 46 B 15/00

X 8206-3B

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

50発明の名称

洗浄用ブラシ

顧 平2-334512

@出 願 平2(1990)11月29日

@発明者 小野田

金 児

大阪府大阪市天王寺区大道3丁目2番12号 株式会社シケ

ン内

@発明者中川

奈良県北葛城郡当麻町大字尺土312番地

の出願人 株式会社シケン

大阪府大阪市天王寺区大道3丁目2番12号

网代 理 人 弁理士 北村 修

明細・音

- 1 発明の名称 洗浄用プラシ
- 2 特許請求の範囲
- 1. 洗浄時に外界光を受けて光電気化学反応が 生起されるN型半導体(10c)が、N型半導体 材料(10b)をブラン構成部材(10a)の表面に 蒸着して設けられている洗浄用ブラシ。
 - 2 前記ブラシ構成部材(10a) が、集束して植 設されている複数のブラシ毛(2) の内の一部 のブラシ毛である請求項1 記載の洗浄用ブラ シ。
- 3 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、洗浄時に外界光を受けて光電気化学反応が生起されるN型半導体を設けて、その分極作用と還元作用とで被洗浄物を効果的に洗浄できるよう構成してある洗浄用プランに関する。

〔従来の技術〕

冒記洗浄用ブラシとして例えば歯ブラシや物品洗浄具があり、本来のブラシ構成部材とは別の、N型半導体が設けられている半導体部材を固定して構成している(例えば特公昭60-57340号公報、特開昭 59-211409号公報、実開昭 60-147353号公報参照)。

(発明が解決しようとする課題)

かかる洗浄用ブラシを製造するに際して、本来のブラシ様成部材を組付ける工程に加えて、 別部材である半導体部材を固定する工程が別途 必要となり、部品点数が増えて製造工程が複雑 化する欠点がある。

更に、半導体部材を別途固定する機成上、長期使用の内にその半導体部材だけがブラン本体 から脱落してしまうおそれも増大する。

本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、N型半導体の取り付け手段を工夫することにより、N型半導体が設けられている別部材を別途固定するという特別な工程を要することなく簡便に製造でき、しかも長期に亘って使用

可能なN型半導体付の洗浄用ブラシを提供する ことを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成する為の本発明による洗浄用ブラシの特徴構成は、洗浄時に外界光を受けて光電気化学反応が生起されるN型半導体が、N型半導体材料をブラシ構成部材の設面に蒸着して設けられている点にあり、かかる構成から次の作用効果を姿する。

(作用)

N型半導体材料のブラシ糖成部材表面への蒸 猫でN型半導体を設けたから、組付け部品点数 が減り、半導体部材を別に固定する工程を要す ることなく、本来のブラシ糖成部材を組付ける ことでN型半導体も同時に固定される。

(発明の効果)

N型半導体が設けられている別部材を別途固定するという特別な工程を要することなくN型半導体を固定して簡便に製造でき、しかもN型半導体が本来のブラン様成部材と一体になって

3

導体層を裘面に形成してある丸棒(6) が雌型族 合部(3) に対する嵌合方向に向けて突設されて いる。

前記丸棒(6) のN型半導体層は二酸化チタン (T₁0₂)で、丸棒状の金属チタン(T₁)を1200万至1500℃で2万至10分間赤熱化してその表面に焼成されるものである。

前記植毛部(A)の茲部側に、両嵌合部(3).(5) どうしの嵌合による植毛部(A) と握柄部(B) と の連結時に前述のN型半導体層を形成してある 丸棒(6) が入り込む空洞部(7) が形成され、こ の空洞部(7) は連通孔(7a).(7b) を介して基材 (1)の前後面側に開放されている。

第1図に示すように、前記ブラシ毛(2)の東はU字状に屈曲されて、基材(1)に形成してある複数(実施例では24個)の有底筒状の植毛穴(8)に押し込まれ、植毛穴(8)に無理底めした平板状の平線(9)でその抜け出しが阻止されている。

前記植毛穴(8) の各々に押し込まれているブ

いるのでN型半導体だけが先に脱落するおそれ もなく、長期に亘って使用できる。

(第1 実施例)

第3図乃至第5図は、植毛部(A)と握柄部(B) とが辞脱自在に構成されている、洗浄用ブラシ の一例としての歯ブラシを示す。

前配植毛部(A)は、透明な合成樹脂製基材(1)の一側面側に、透明なナイロン製のブラシ毛(2)の複数(実施例では21乃至22本)を束にして植毛して構成され、堰柄部(B)側に対して弾性的に嵌合される雌型嵌合部(3)が形成されている。

前記握柄部(B) は、合成樹脂製の握柄(4) に 植毛部(A) の雌型嵌合部(3) に対して嵌合され る雄型嵌合部(5) を形成して構成され、N型半

4

ラシ毛(2) の東には、表面にN型半導体成分を 蒸着した半導体ブラシ毛(10)が 1 本だけ含まれ ている。

前記半導体ブラシ毛(10)は、ナイロン製フィラメント(10a) の表面にN型半導体材料である金属チタン(T_1)(10b)を蒸着した後、その表面を酸化して 0.1乃至 1.0μ m程度の極めて薄い 順厚のアナターゼ型の二酸化チタン(T_1 0 $_1$)層 (10c)を形成したものを所定長さに切断して が成してあり、第2図に示すように、外周面に二酸化チタン(T_1 0 $_1$)(10c)の 脚膜が形成され、その切断面に金属チタン(T_1)(10b) が露出している機造を有している。

そして、歯みがき時に歯牙側の水分が半導体プラシ毛(10)に接触し、かつ外界光が直接に或いは透明のプラシ毛(2)や透明な基材(1)を通過して間接に半導体プラシ毛(10)表面のN型半導体(10c)に照射されると、光電気化学反応が生起される。

本実施例においては、各プラシ毛(2)の束に

ついて1本だけ半導体ブラシ毛(10)を含ませる 機成となっているので、歯磨き時に使用者に与 える異物感が少なく、通常の歯ブラシによる歯 磨き時と略同じ感触で使用できる。

又、本実施例の半導体ブラシ毛(10)においては、ナイロン製フィラメント(10a)の表面に金属チタン(T₁)(10b)を蒸着してからその表面を酸化して、N型半導体である二酸化チタン(T₁0₂)層(10c)が 0.1万至 1.0μm程度の極めて薄い膜厚で設けられ、内部の金属チタン(T₁)(10b)厚さも薄いから、光電気化学反応の効果を、図期的に飛躍させることが可能となり、さらに、二酸化チタン(T₁0₂)の結晶構造を、従来用いられているルチル型をとることなく、アナターゼ型をとっているため、その効果をより多く発揮させることが可能となった。

N型半導体と唾液等の水分が接触すると、N 型半導体のフェルミレベルと唾液等の水分の酸 化還元電位の差により、N型半導体の電子の一部が唾液等の水分へと移行し、N型半導体は、 パルク内に向かって電位勾配が形成され、結果 的にN型半導体の溶液界面にShottoky障壁が形成される。このようにしてできたものを空間電 荷層と呼ぶが、N型半導体の厚みの大小により、 その空間電荷層は異なることになる。 つまり、従来のようにN型半導体の薄膜の厚

つまり、従来のようにN型半導体の薄膜の厚みが、約1μm程度以上であると、かなり深い 電位勾配が生じでShottoky障壁が高いが、本実 施例におけるように、極めて薄い膜薄を有する N型半導体では、深い電位勾配ができず、Shot toky障壁もかなり低いものとなる。

この状態のN型半導体に光照射がなされると、 価電子帯の電子の一部が、伝導帯へと励起され、 価電子帯には電子の抜け殻である正孔が、また 伝導帯には、エネルギーに富んだ励起電子が生 じる。

この励起電子は、前記電位勾配により、N型 半導体内部へさらにその内部の金属チタン部を

7

経由して、暗部へと移動することになるが、N型半導体や金属チタン部の厚みが大きい際には、この励起電子は、正孔と再結合してしまうためにその目的とする光電気化学作用が十分には発揮できないという欠点がある。

また正孔は、エネルギー的に見てかなり低い 位置にある強い酸化力を有しているために、溶 液中の物質を十分に酸化することが可能となる。 一方励起電子は、エネルギー的にみてかなり高 い位置にあるために、溶液中の物質を十分に還 元することが可能となる。

しかし前記したように、従来のようにN型半導体の薄膜の厚みが約1μm程度あると、当然暗部においてもかなり高いShottoky障壁があるために、溶液中の物質への電子の供給が起こりにくく、還元反応の効率は低下し、その目的とする光電気化学反応作用が十分には発揮できない。

ところが、本実施例のように薄膜金属チタン 上に作製した極めて薄いN型半導体皮膜を有す .8

るものは、前記したようにN型半導体皮膜や内部金属チタンの厚みのために、正孔と励起電子が再結合し反応効率を低下させることが少ないものとなり、暗部においても低いShottoky障壁しかないために、伝導帯の励起電子は、たやすく溶液中の物質へ電子を供給することが容易になり、還元反応の効率を向上させることになるのである。

また本実施例のように極めて海い膜厚を持つ N型半導体は、前記したような空間電荷層の電位勾配を必ず必要とするものではなく、微粒子半導体粉末に見られるような微粒子効果と同様に正孔、励起電子は、拡散過程にもとずき、表面に達することが可能であるという点もあり、そのなし遂げえる効果は、画期的に向上さしえるものである。

さらに、N型半導体においては金属チタンを 1200~1500℃にて数分間焼成することにおいて、 ルチル型の結晶構造を有している物と考えられ るが、本実施例のN型半導体ではアナターゼ型 結晶を有しているためにそのエネルギーの位置 の関係より、ルチル型のものより多くの反応効 率を上げることが期待できるのである。

またN型半導体の一部に金属チタンを露出させているために、前記した伝導帯の励起電子は、より一層に溶液中の物質へと電子供給が容易になるために、その効果がより一層期待できる物となる。

このようなN型半導体の一部に金属を露出させる方法としては、薄肉の金属チタン表面を酸化して形成した二酸化チタンを切断することにかぎらず、これをプレスして皮膜の亀裂部分から内部金属を露出させる方法によってでもよい。

尚、このN型半導体としては、その化学的安定性や価電子帯、伝導帯のエネルギーレベルから考えて、酸化チタンがもっとも優れているが、他に酸化亜鉛、三酸化二鉄等でもよい。

〔第2実施例〕

第6図に示すように、基材(1)のブラシ毛(2) の東が植毛されていない側に第1 実施例と同様

1 1

- ホ. 本発明の洗浄用ブラシの一例としての歯ブラシは、当該歯ブラシに内蔵させた電池からの電力供給により、身体を導電体としていいでいる。 極側とした歯ブラシと、陽極側とした歯牙、肉の間に電流を流し、陽極側である歯牙、肉まわりの口腔内汚物をマイナス電位に保たれた歯ブラシに引き寄せるように構成した洗浄部が並設されているものであっても良い。
- へ、本発明の洗浄用ブラシの一例としての歯ブ ラシは、電動式の歯ブラシであっても良い。
- ト. 第1 実施例において、歯ブラシの握柄部に 設けたN型半導体を省略し、単に植毛部と握 柄部とが着脱自在に構成されている歯ブラシ として実施しても良い。

尚、特許請求の範囲の項に図面との対照を便利にする為に符号を記すが、該記入により本発明は添付図面の構成に限定されるものではない。

4 図面の簡単な説明

の手段でN型半導体(10c)を形成して実施して も良い。

その他の様成は第1 実施例と同様である。 (その他の実施例)

- イ. 本発明の洗浄用ブラシは、物品洗浄用のブラシであっても良い。
- ロ. 本発明の洗浄用プラシは、N型半導体その もの (例えば二酸化チタシ(T,O₁)) がブラシ 構成材の表面に蒸着して設けられるものであ っても良い。
- ハ. N型半導体材料の蒸箱手段には、真空蒸箱 する方法や化学蒸着 (CVD) する方法があ
- ニ. 本発明の洗浄用プランの一例としての歯ブラシは、第1 実施例で示した植毛部と握柄部とが発脱自在に徴成されているものに限定さ

1 2

図面は本発明に係る洗浄用ブラシの実施例を示し、第1図、第2図は要部斜視図、第3図は断面側面図、第4図は平面図、第5図は植毛部と握柄部とを分離した平面図である。第6図は別実施例を示す斜視図である。

(2)……ブラシ毛、(10a)……ブラン構成部材、(10b)……N型半導体材料、(10c)……N型半導体材料、(10c)……N型半導体。

代理人 弁理士 北 村 修

